

2SK777



2056

NチャネルMOS形
シリコン電界効果トランジスタ

超高速スイッチング用

©2061

特長 ・低オン抵抗, 超高速スイッチング.

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$

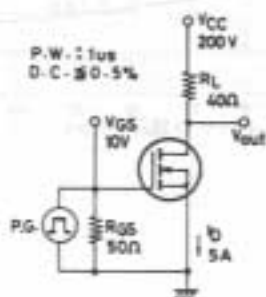
			unit
ドレイン-ソース電圧	V_{DS}	450	V
ゲート-ソース電圧	V_{GS}	± 20	V
ドレイン電流(D.C.)	I_D	10	A
ドレイン電流(P&A)	$I_{D\ peak}$	20	A
許容損失	P_D	120	W
接合部温度	T_J	150	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

$T_c=25^\circ\text{C}$

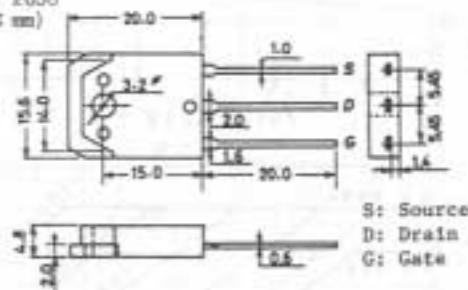
電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$

			min	typ	max	unit
ドレイン-ソース降伏電圧	V_{DS}	$I_D=1\text{mA}, V_{GS}=0$	450			V
ドレイン-ソースしゅ断電流	I_{DSS}	$V_{DS}=450\text{V}, V_{GS}=0$			1.0	mA
ゲート-ソースもれ電流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0$			± 100	nA
ゲート-ソースしゅ断電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=1\text{mA}$	1.5		4.0	V
順伝達ファクタ	$ Y_{fs} $	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=5\text{A}$	3	4.5		S
飽和抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D=5\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$		0.47	0.65	Ω
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=20\text{V}, f=1\text{MHz}$		1600		pF
出力容量	C_{oss}	$V_{DS}=20\text{V}, f=1\text{MHz}$		250		pF
帰還容量	C_{rss}	$V_{DS}=20\text{V}, f=1\text{MHz}$		80		pF
ターンオン遅延時間	$t_d(on)$	$I_D=5\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ $V_{CC}=200\text{V}, R_{GS}=50\Omega$		30	60	ns
立ち上がり時間	t_r			90	180	ns
ターンオフ遅延時間	$t_d(off)$			250	500	ns
下降時間	t_f			80	160	ns

スイッチングタイム測定回路



外形図 2056
(unit: mm)



S: Source
D: Drain
G: Gate

SANYO: TO3PB

注: ゲート-ソース間には保護回路ダイオードは入っていないため 取扱いに十分注意すること。